

Сведения о ведущей организации,
назначенной по диссертации **Березина В.В.**

«Моделирование и проектирование широкополосных диодных умножителей частоты КВЧ-диапазона», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.12.07 – «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии».

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество Научно - производственная фирма «Микран»
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	АО «НПФ «Микран»
Место нахождения	г. Томск
Почтовый индекс, адрес организации	634041, Томск, пр-т Кирова, 51д
Телефон (при наличии)	+7 3822 90-00-29
Адрес электронной почты (при наличии)	mic@micran.ru
Адрес официального сайта (при наличии)	www.micran.ru
Список основных публикаций работников организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	
1.	Дроздов, А.В. Моделирование диодов с барьером Шоттки для применения в монолитных интегральных схемах СВЧ / Дроздов А.В., Данилов Д.С., Юнусов И.В., Гошин Г.Г. // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2018. Т. 21. № 1. С. 28-31.
2.	Федин, И.В. AlGaN/GaN диоды с барьерами Шоттки на основе TA, NI, WSI и TIN / Федин И.В., Ерофеев Е.В., Федина В.В. // Вестник СибГУТИ. 2018. № 3. С. 62-68.
3.	Дроздов, А.В. Монолитная интегральная схема двойного балансного смесителя диапазона частот 5-26 ГГц / Дроздов А.В., Дроботун Н.Б., Гошин Г.Г., Хорошилов Е.В. // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2017. Т. 20. № 1. С. 23-25.
4.	Хорошилов, Е.В. Сверхширокополосный коаксиально-микрополосковый переход с диапазоном частот 0-50 ГГц / Хорошилов Е.В., Козлов С.В., Павлов С.В., Дроздов А.В. // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2017. Т. 20. № 3. С. 128-131.
5.	Доценко, В.В. Исследования, методы проектирования, разработка технологий электронной компонентной базы, радиолокационной и измерительной базы, радиолокационной и измерительной аппаратуры на пути перехода к цифровому производству / Доценко В.В., Малютин Н.Д. // Электронные средства и системы управления. 2017. № 1-2. С. 221-229.
6.	Дроботун, Н.Б. GaAs монолитная интегральная схема утроителя частоты на основе диодов с барьером Шоттки с входным диапазоном частот 7-17 ГГц / Дроботун Н.Б., Дроздов А.В., Данилов Д.С., // Электронные средства и системы управления. 2017. № 1-2. С. 229-231.
7.	Алексеев, К.А. Полосно-пропускающий фильтр в монолитно-интегральном исполнении / Алексеев К.А., Коровкин Е.Н., Арыков В.А. // Электроника и микроэлектроника СВЧ. 2017. Т. 1 № 1 (1). С. 374-378.
8.	Гошин, Г.Г. Исследование способов увеличения направленности симметричных направленных ответвителей диапазона 2-20 ГГц / Гошин Г.Г., Зорин А.В., Подлиннов С.А., Попков А.Ю. Фатеев А.В. // Доклады Томского

	государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2016. Т. 19. № 3. С. 5-7.
9.	Гущин, В.А. СВЧ МИС на основе GaAs-PIN-диодов для управления амплитудой сигнала в диапазоне частот 4-27 ГГц / Гущин В.А., Юнусов И.В., Плотникова А.Ю. // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2014. № 3 (33). С. 70-74.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д212.165.01
д.т.н., профессор



Ю.Г. Белов